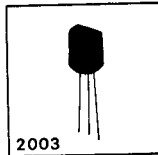


# 2SA1017

## 2SC2363

低周波電力増幅  
40 - 50W出力  
フリドライバ用



PNP / NPN Epitaxial Planar Type Silicon Transistor

For Predriver of 40 to 50 W AF Amplifier

- ★A complementary pair.
- ★( ) shows 2SA1017 only.
- ★For the details, see 2SC2363 section.

⊖ C511B

( )内は 2SA1017の場合を示す。

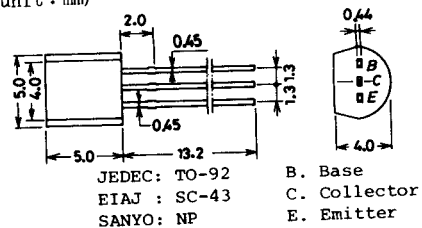
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$		unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	(-) 120 V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	(-) 100 V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$	(-) 5 V
コレクタ電流	$I_C$	(-) 50 mA
ピークコレクタ電流	$i_{cp}$	(-) 100 mA
コレクタ損失	$P_C$	500 mW
接合部温度	$T_j$	125 $^\circ\text{C}$
保存周囲温度	$T_{stg}$	-55 ~ +125 $^\circ\text{C}$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$		min	typ	max	unit
コレクタシャ断電流	$I_{CB0}$ $V_{CB} = (-) 80V, I_E = 0$		(-) 1.0		$\mu\text{A}$
エミッタシャ断電流	$I_{EB0}$ $V_{EB} = (-) 4V, I_C = 0$		(-) 1.0		$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$\beta_{FE}^*$ $V_{CE} = (-) 6V, I_C = (-) 1\text{mA}$	100*		560*	
利得帯域幅積	$f_T$ $V_{CE} = (-) 6V, I_C = (-) 1\text{mA}$		(110) 130		MHz
出力容量	$C_{ob}$ $V_{CB} = (-) 10V, f = 1\text{MHz}$	(1.0)	(2.2)	(3.0)	pF
		1.0	1.8	2.5	pF
C-E 飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ $I_C = (-) 10\text{mA}, I_E = (-) 1\text{mA}$			(-) 0.5	V
C-B 降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$ $I_C = (-) 10\mu\text{A}, I_E = 0$	(-) 120			V
C-E 降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$ $I_C = (-) 1\text{mA}, \beta_{FE} = \infty$	(-) 100			V
E-B 降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$ $I_E = (-) 10\mu\text{A}, I_C = 0$	(-) 5			V

※ 2SA1017, 2SC2363は 1mA  $\beta_{FE}$  によりつぎのように分類している。

100	E	200	160	F	320	280	G	560
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

外形図 2003  
(unit: mm)



◆詳しくは2SC2363のページをご覧ください。